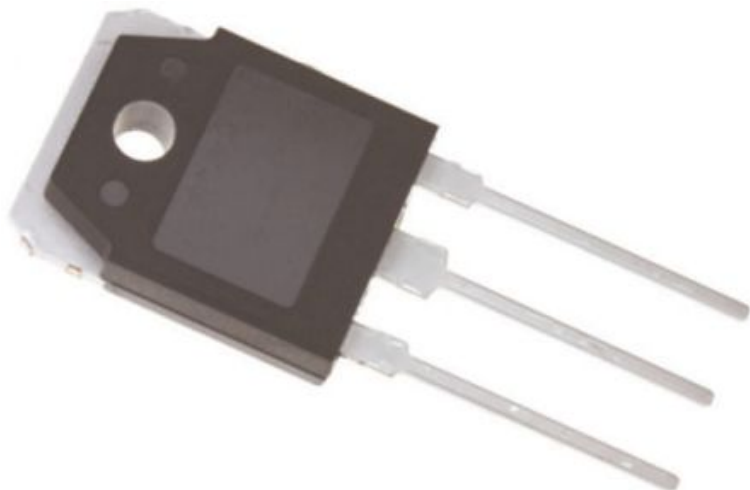


Transistor FQA6N90C MOSFET N de puissance TO-3PN 900V 6A

CARACTERISTIQUES GENERALES :	
Réf :	SAV6N90C



Transistor FQA6N90C MOSFET N de puissance TO-3PN 900V 6A

Transistor FQA6N90C MOSFET N de puissance TO-3PN 900V 6A

Type de canal : N

Courant continu de Drain maximum : 6 A

Tension Drain Source maximum : 900 V

Type de boîtier : TO-3PN

Type de montage : Traversant

Nombre de broches : 3

Résistance Drain Source maximum : 2,3 ?

Mode de canal : Enrichissement

Tension de seuil minimale de la grille : 3V

Dissipation de puissance maximum : 198 W

Configuration du transistor : Simple

Tension Grille Source maximum : -30 V, +30 V

Nombre d'éléments par circuit : 1

Largeur : 5mm

Longueur : 15.8mm

Hauteur : 18.9mm

Matériau du transistor : Si

Série : QFET



Température de fonctionnement minimum : -55 °C
Charge de Grille type @ Vgs : 30 nC @ 10 V
Température d'utilisation maximum : +150 °C

PROZIC
113 Ancienne route Imperiale
31120 Portet-sur-Garonne
05 82 950 710

Packaging :		
Dimensions produit :		
Données non contractuelles		